

FORMATION METHOD OF SILICON OXIDE FILM

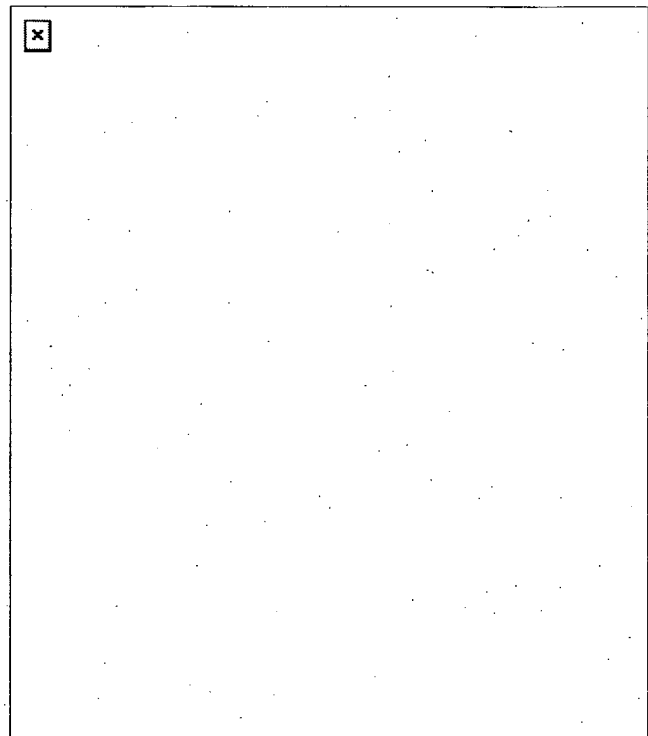
Patent number: JP8236518
Publication date: 1996-09-13
Inventor: SAITO MASAYOSHI; HONMA YOSHIO; KUDO YUTAKA
Applicant: HITACHI LTD;; HITACHI ELECTRON ENG CO LTD
Classification:
- international: H01L21/316; C23C16/50; H01L21/205; H01L21/285; H01L21/768; H05H1/46
- european:
Application number: JP19950039671 19950228
Priority number(s):

[View INPADOC patent family](#)

Abstract of JP8236518

PURPOSE: To form a silicon oxide film which is small in an OH content group and excellent in moisture permeability preventing properties and coated with a high offset.

CONSTITUTION: A mixed gas of an oxidizing gas containing alkoxy silane and hydrogen is introduced, thereby forming a silicon oxide film having an Si-H binding based on a plasma CVD method. This makes it possible to manufacture a semiconductor device having a high density and high reliability multilayer wiring at low cost.



THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平8-236518

(43) 公開日 平成8年(1996)9月13日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 1 L 21/316			H 0 1 L 21/316	X
C 2 3 C 16/50			C 2 3 C 16/50	
H 0 1 L 21/205			H 0 1 L 21/205	
21/285			21/285	C
21/768		9216-2G	H 0 5 H 1/46	M
審査請求 未請求 請求項の数 4 O L (全 5 頁) 最終頁に続く				

(21) 出願番号 特願平7-39671

(22) 出願日 平成7年(1995)2月28日

(71) 出願人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(71) 出願人 000233480

日立電子エンジニアリング株式会社

東京都渋谷区東3丁目16番3号

(72) 発明者 斉藤 政良

東京都国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地

株式会社日立製作所中央研究所内

(72) 発明者 本間 喜夫

東京都国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地

株式会社日立製作所中央研究所内

(74) 代理人 弁理士 小川 勝男

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 シリコン酸化膜の形成方法

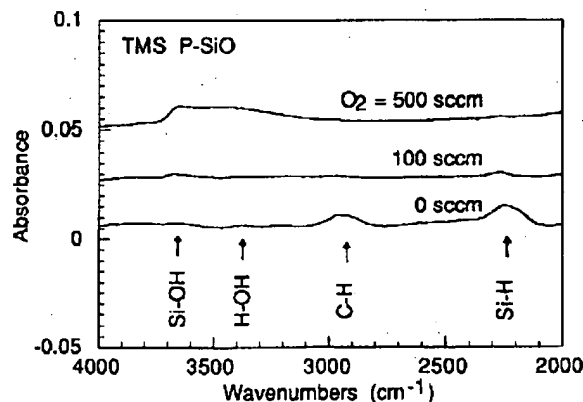
(57) 【要約】

【目的】 含有OH基が少なく、水分透過阻止特性に優れると同時に高段差被覆性のシリコン酸化膜を形成する。

【構成】 アルコキシシランと酸素を含む酸化性ガスの混合ガスを導入し、プラズマCVD法でSi-H結合を有するシリコン酸化膜を形成する。

【効果】 高密度で信頼性の高い多層配線を有する半導体装置の低コスト製造が可能となる。

図4



【特許請求の範囲】

【請求項1】 Si-H結合を有するアルコキシドをシリコン源として酸素源と混合しプラズマCVD法によりSi-H結合を含有するシリコン酸化膜を形成することを特徴とするシリコン酸化膜の形成方法。

【請求項2】 請求項1記載において、生成膜の赤外吸収における 2100 cm^{-1} から 2400 cm^{-1} の範囲のSi-Hのアブソーブランスの最大値が、 3700 cm^{-1} から 3800 cm^{-1} の範囲のSi-OHのアブソーブランスの最大値の $1/3$ 以上であるシリコン酸化膜の形成方法。

【請求項3】 請求項1または2において、前記シリコン源がトリメトキシシランであるシリコン酸化膜の形成方法。

【請求項4】 請求項1、2または3において、前記シリコン酸化膜を下敷き層として、シリコン酸化膜を形成するシリコン酸化膜の形成方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明はシリコン酸化膜の製造方法に係り、特に、半導体装置の多層配線における上下配線層間を絶縁するシリコン酸化膜のCVD法による形成方法に関する。

【0002】

【従来の技術】 従来からCVD法による半導体装置用シリコン酸化膜の形成において、モノシラン(SiH_4)が原料として用いられてきた。しかし、大規模集積回路(LSI)の高密度化にともなってパターン寸法が微細化され、今やサブミクロンの加工が行なわれる段階となり、いくつかの支障が生じてきた。例えば、多層配線の製造プロセスでは配線間隔の寸法がサブミクロンで、配線間に対する深さ(配線の高さ)の比(アスペクト比)が1を越える部分への高品質の絶縁膜の埋め込みが必須となってきたが、 SiH_4 を用いたCVD法ではこのような微細で高アスペクト比の溝や段差部へ十分な絶縁膜形成ができないことがあげられる。また、あえて適用しようとする、配線間の短絡や被覆性の劣った部分からの水分の浸入でアルミニウム配線が腐食し断線する等の問題が生じる。また、 SiH_4 は酸素(O_2)や酸化性ガスの亜酸化窒素(N_2O)と接触すると容易に反応してパーティクルを発生しやすいことも問題である。また、 SiH_4 は常温で空気に触れると燃える自己発火性ガスであり、支燃性ガスと混合すると爆発性を有する危険な材料である。この SiH_4 の使用にあたっては特定高圧ガスに関する条例に沿った設備を設けて安全性に十分気を配った運用を行わなければならない、このためのコストも決して安価ではない。

【0003】 以上のような SiH_4 を用いたプラズマCVD法の欠点を克服するため、テトラエチルオルトシリケート(以下TEOS)が SiH_4 にかわる原料として用いられるようになってきた。TEOSを用いたプラズ

マCVD法で形成したシリコン酸化膜は SiH_4 を用いた場合よりも段差被覆性に優れ、またTEOSは自己発火性もない比較的安全な原料である。

【0004】 しかし、TEOSを用いたプラズマCVD法で形成したシリコン酸化膜は、緻密性、水分の透過阻止特性、含有OH基量でまだ問題を残している。 SiH_4 をソースとしてプラズマCVD法で形成したシリコン酸化膜に比べると、耐水性が劣る。これは膜中にSi-H結合が殆ど存在せず、OH基が比較的多いためと考えられる。また、含有OH基は極性が大きくシリコン酸化膜の誘電率を大きくする。TEOSを用いたプラズマCVD法で膜形成後 $600\sim 800^\circ\text{C}$ 程度の熱処理を行うことができればOH基を低減して緻密なシリコン酸化膜を得ることができるが、アルミニウム系配線が劣化するので適用できない。また、更にTEOSを用いたプラズマCVD法で形成したシリコン酸化膜上にTEOS等のアルコキシドとオゾンとを用いたCVD法で流動性シリコン酸化膜を形成しようとする、生成膜表面が凹凸の激しい形状となったり、生成膜の膜厚のばらつきが大きくなるなどのいわゆる下地依存性が顕著になるという問題があった。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】 本発明の目的は、生成膜中のOH基の低減または除去及び耐水性向上に関する課題と、高段差被覆性膜形成の課題と、オゾンCVD法の膜形成において下地依存性をなくすという課題を同時に解決する平坦性の優れたシリコン酸化膜の形成方法を提供することにある。

【0006】

【課題を解決するための手段】 上記課題は、SiソースとしてSi-H結合を有するアルコキシドを用いて O_2 または N_2O 等の酸化ガスと混合したガスを導入し、生成膜中のSi-H/Si-OHのアブソーブランス比が $1/3$ 以上となるようにSiソースと O_2 または N_2O の流量比を設定してプラズマCVD法でシリコン酸化膜を形成するという手段により解決できる。

【0007】

【作用】 本発明は、Si-H結合を有するアルコキシドをSiソースとして使用する。この種のアルコキシドはSi-O結合を分子内部に持つので、アルコキシド共通の性質として高段差被覆性を確保するよう作用し、また空気に触れた場合の自己発火性もなくプロセス安全性を飛躍的に高めて設備のコストを低減するよう作用し、また SiH_4 に比べてパーティクルも低減するよう作用する。

【0008】 本発明のSiソースに含まれるSi-H結合は、酸化ガスを適正領域の流量に制御することにより生成膜中にも取り込まれる。この膜中のSi-H結合は浸入しようとする水分をトラップするよう働くので水分の膜中の透過を阻止するよう作用する。膜表面に存在す

3

るSi-H結合は、表面反応が容易に起こる活性サイトとして働き、表面における均一なシリコン酸化膜形成反応が進行するよう作用する。一方、表面のSi-OH結合は極性が強く、反応ガス中の生成物である酸素を持つ炭素化合物と結び付き易く、この炭素化合物が表面に付いた状態では表面反応が進行しにくくなるように作用する。従って、均一で高速の膜生成を行うには、表面におけるSi-H結合密度が大きくてSi-OH結合の密度が小さいことが、すなわち、Si-H/Si-OH比が大きいことが有効である。シリコン酸化膜のシロキサン結合の乱れた部分の大部分にHまたはOHが結合するので、膜中のSi-H結合を増加させるとSi-OH結合は減少するという特性がある。そして実験によるとSi-H/Si-OHのアブソーパンス比が1/3以上の生成膜は水分の透過を阻止するように作用し、また、この膜を下敷き膜としてのオゾンCVDにおいては下地依存性をなくすよう作用する。

【0009】

【実施例】本発明の実施例を図を用いて詳細に説明する。シリコン酸化膜の形成に用いたプラズマCVD室の構造を図1に示す。Siソースにトリメトキシシラン（以下TMS）を使用した場合を例として説明する。TMSは液体ソースでステンレス製の容器に入れ、搬送ガスである窒素ガスをバブリングしてCVD室に導入した。TMSの容器の温度は25℃、搬送窒素ガスの流量は0.2slmとした。容器からCVD室までのガス配管はガスの吸着や液化を抑えるため温度勾配をつけて60～100℃に保った。ガス導入部1からTMSとO₂とN₂の混合ガスを入れ、下部電極3の上に直径4インチの基板4を置き、上部電極2と下部電極3の間にRF電力を印加した。RFの周波数は50kHz、RF電力は100Wとした。なお、上部電極2と下部電極3はそれぞれ独立に位置を設定可能で、ここでの電極間隔は12mmとした。CVD室には反応ガスを分析するための赤外線透過窓7が装備されている。

【0010】次に、TMSを導入し圧力4Torrとした場合の赤外吸収スペクトルを図2に示した。このガスは図2に示した構成で、C-H、Si-H、Si-Oを含んでいる。図3は高周波（RF）電力を印加したプラズマ状態の反応ガスの赤外吸収スペクトルである。プラズマ状態とすることにより、導入ガスの他に1775cm⁻¹にホルムアルデヒド（HCHO）が、2360cm⁻¹付近にCO₂が、3740cm⁻¹付近にSi-OH結合が、3400cm⁻¹付近にシリカに吸着したH₂Oが、また3600cm⁻¹付近及び1600cm⁻¹付近に分子状のH₂Oが少量ではあるが認められる。

【0011】次に、形成したシリコン酸化膜の赤外吸収スペクトルの一例を図4に示す。表示の関係上、酸素100sccmと500sccmの場合には、アブソーパンスをそれぞれ0.025と0.05シフトさせて示してある。膜

4

の形成条件は圧力1Torr、電極間隔12mm、TMSの搬送窒素ガスが0.2slm、基板温度350℃、希釈窒素ガスが1slm、酸素が0～500sccmとした。酸素が500sccmの場合には3660cm⁻¹付近のSi-OHと3400cm⁻¹付近の吸着したH₂Oが認められ、TEOSを原料とした場合のシリコン酸化膜と同等のスペクトル形状となっている。酸素が100sccmの場合にはSi-OHのアブソーパンスは減少し、2200cm⁻¹付近にSi-Hが認められる。酸素を0sccmとした場合にも膜は成長する。この時Si-OHは極めて小さな値まで減少し、Si-HとC-Hのアブソーパンスが大きくなる。ここで図4のアブソーパンスにつき更に詳しく酸素流量依存性を測定した結果を図5に示した。OH基関係のアブソーパンスは酸素流量の増加に伴って増加し、Si-H、C-Hは酸素流量増加に伴って減少する。TMSと酸素の流量比を変えることにより、生成するシリコン酸化膜中のSi-H結合やOH基の量を変えることができることが確かめられた。

【0012】TMSと性質の類似した材料にトリエトキシシラン（TES）がある。TESをSiソースとした場合には、TMSの場合と同様の酸素流量依存性を示すが、同じ流量で比較した場合、膜中のC-Hのアブソーパンスが20～50%大きいという結果となった。

【0013】次に、TMSを用いた場合の段差部被覆形状を評価するため、幅350nm、深さ600nmの溝を持つ試料を用いて平坦部のシリコン酸化膜が300nmとなる条件の断面をSEMで観察した。段差端のオーバーハングの状態から判断して、TMSをSiソースとした場合にはTEOSを用いた場合とほぼ同等の形状が得られ、SiH₄を用いた場合の形状よりも優れていることが分かった。

【0014】次に、生成膜の屈折率nの酸素流量依存性を図6に示した。酸素流量が大きい場合には、TEOSを原料としたシリコン酸化膜と同等の値となっているが、酸素流量を減少させると屈折率は増加する。酸素流量が20sccm以下の場合には屈折率の増加は著しい。

【0015】次に、濃度0.5%の希釈HF液によりシリコン酸化膜のエッチング速度を測定した結果を図7に示した。一般にLSIの多層配線に使用されているTEOSを原料としたプラズマCVD法により形成したシリコン酸化膜は通常10～12nm/minであるから、熱酸化膜の2.5nm/minにかなり近い緻密な膜である。酸素流量を増加させると図7に示したとおりエッチング速度は僅かに増加した。

【0016】生成膜の耐水性は、1250～1300cm⁻¹付近に見られるリン酸化物（P=O）の変化から評価した。膜厚200nmのフォスフォシリケートガラス（PSG）をSi基板上に堆積して、その上にTMSおよびSiH₄を用いたプラズマCVD法で膜厚400nmの2種類のシリコン酸化膜を形成した。125℃、2気圧、

5

150時間のプレッシャークッカー試験により評価した結果、いずれの試料にも $P=O$ の変化を認めず良好な結果を得た。

【0017】次に、TMSを用いて形成した膜厚200nmのシリコン酸化膜を下敷き膜として、この膜の上にTEOSとオゾンを用いたCVD法で400nmのシリコン酸化膜を形成した場合の表面の凹凸を測定した結果を図8に示した。酸素流量が小さい領域では面粗さは十分小さな値になることが示されている。酸素流量が250sccm以下の領域は図5における $Si-H/Si-OH$ のアブソーパンス比が0.3を越える領域に相当し、この領域がオゾンCVDの下敷き膜として適している。このときオゾンCVD法で形成したシリコン酸化膜には流動性が認められ、段差部で平坦化特性のある優れた被覆形状が得られた。

【0018】ここに示したオゾンCVD法以外であっても、 $Si-H$ 結合を有するシリコン酸化膜を下敷き膜として、この膜の上に無機系や有機系の Si 源ソースを用いたCVD法や塗布膜形成法により形成したシリコン酸化膜を形成しても良い。

【0019】以上、TMSを用いた平行平板型単周波プラズマCVD法によるシリコン酸化膜の形成方法を例として説明を行ったが、 $Si-H$ 結合を有するアルコキシドを Si ソースとして二周波プラズマCVD法や、バイアス印加高密度プラズマ（プラズマ源としてエレクトロンサイクロトロン共鳴（ECR）、インダクタンス結合

6

型プラズマ（ICP）、ヘリコン波方式プラズマ等が知られている）CVD法を用いても良い。

【0020】

【発明の効果】本発明によれば、含有OH基が少なく水分透過阻止特性に優れ、同時に高段差被覆性を有するケイ素酸化膜が形成でき、高密度で多層配線を有する半導体装置の低コスト製造を可能とする。

【図面の簡単な説明】

【図1】プラズマCVD室の説明図。

【図2】TMSガスの赤外吸収スペクトル図。

【図3】プラズマCVD中の反応ガスの赤外吸収スペクトル図。

【図4】本発明のシリコン酸化膜の赤外吸収スペクトル図。

【図5】シリコン酸化膜中分子結合のアブソーパンスの O_2 流量依存性を示す特性図。

【図6】屈折率 n の O_2 流量依存性を示す特性図。

【図7】0.5%フッ酸水溶液によるエッチング速度の O_2 流量依存性を示す特性図。

20 【図8】本発明のシリコン酸化膜上に形成したTEOS- O_3 膜の面粗さの O_2 流量依存性を示す特性図。

【符号の説明】

1…ガス導入配管、2…上部電極、3…下部電極、4…基板、5…RF電極、6…CVD室の壁、7…赤外線観測用窓、8…反応ガス排気口。

【図1】

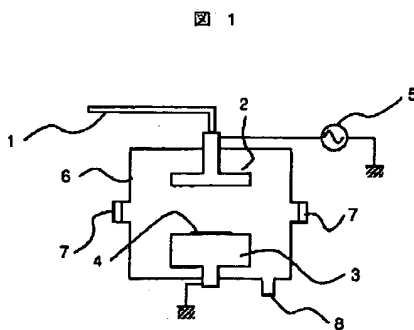


図 1

【図2】

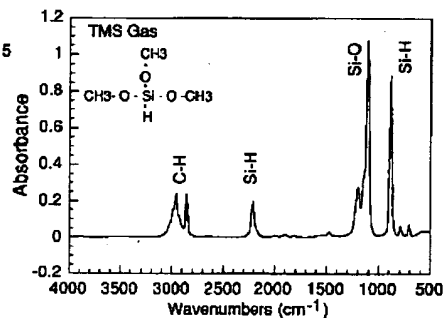


図2

【図5】

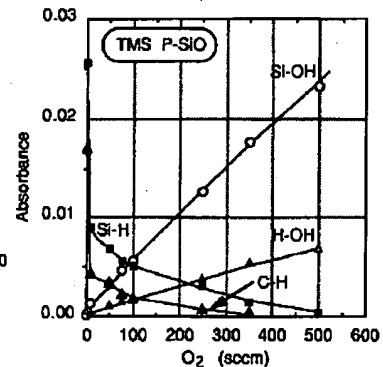
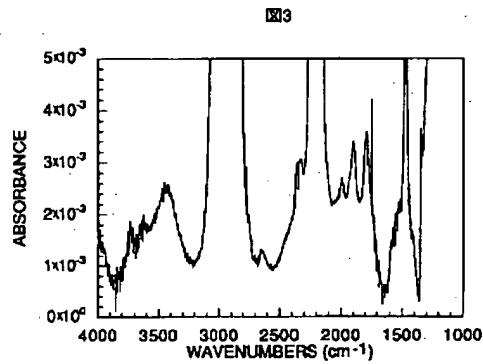
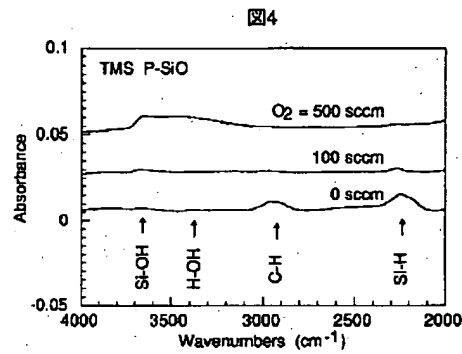


図 5

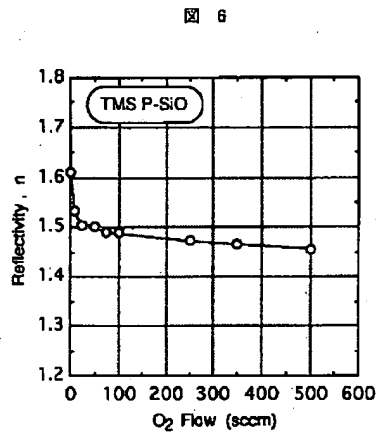
【図3】



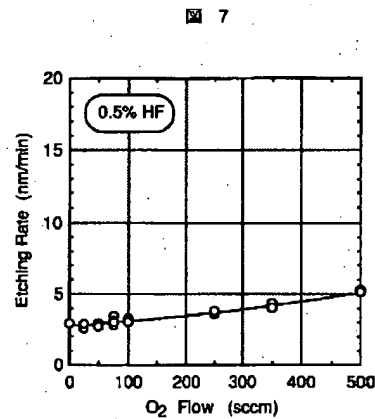
【図4】



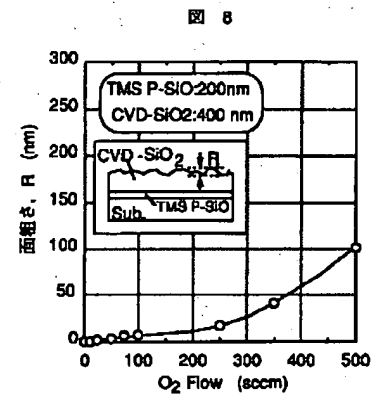
【図6】



【図7】



【図8】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

H05H 1/46

識別記号

弁内整理番号

F I

H01L 21/90

技術表示箇所

P

L

(72)発明者 工藤 豊

東京都渋谷区東3丁目16番3号 日立電子
エンジニアリング株式会社内

THIS PAGE BLANK (USPTO)